

Silicon Schottky Diode

TIV305

8V / 100mW

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

TIV305

Metall-Silizium-Schottky-Barrier-Diode

UHF-Mischer-Diode

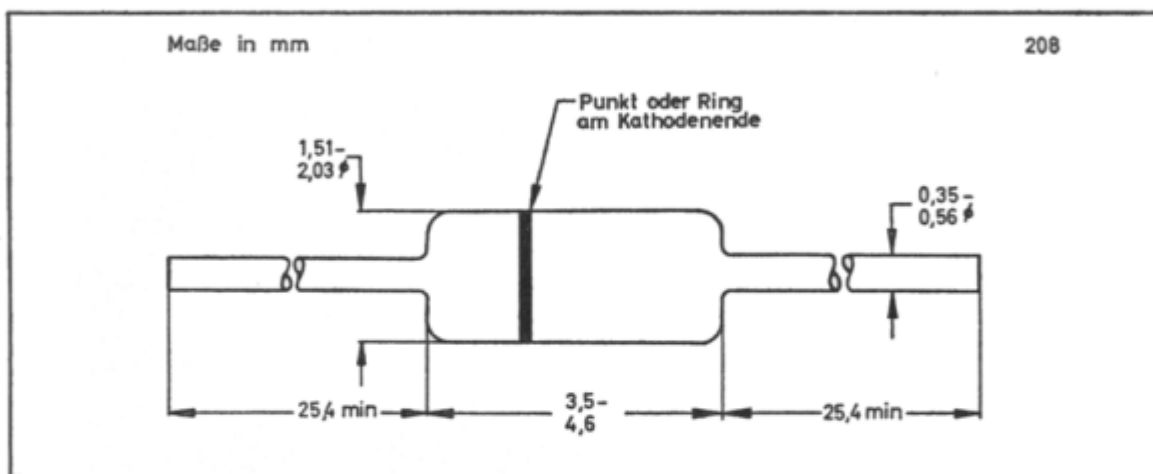
Planar-Konstruktion

Kleiner Rauschfaktor

Hohe Zuverlässigkeit

Mechanische Daten

Die Diode ist in ein hermetisch abgeschlossenes Glasgehäuse eingebaut. Gewicht ca. 0,084 g.

**Absolute Grenzwerte**

Dauerverlustleistung bei (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1)	100 mW
Spitzenenergie bei 25 °C Umgebungstemperatur, $t_p = 2,5$ ns	10 erg
Arbeitstemperaturbereich	-65 °C bis +100 °C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehäuse für 10 s	260 °C

Bemerkung:

1. Lineare Reduzierung auf 100 °C mit 1,33 mW/°C.

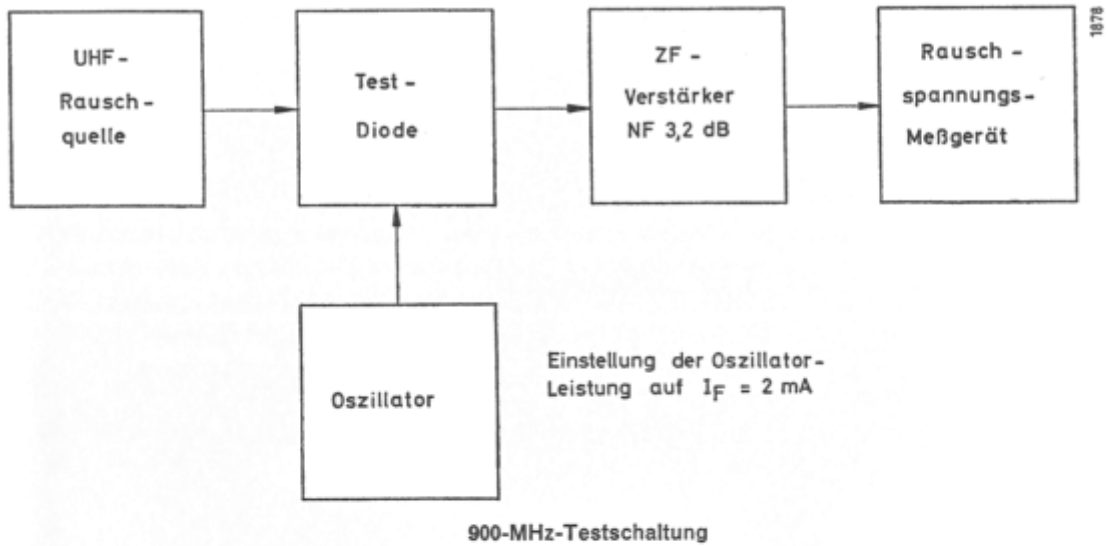
Elektrische Grenzwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$ (wenn nicht anders angegeben)

Parameter	Prüfbedingungen	min	typ	max	Einh.
$U_{(BR)}$ Durchbruchspannung	$I_R = 10\text{ }\mu\text{A}$	4	8		V
I_R Reststrom	$U_R = 3\text{ V}$		0,1		μA
U_F Flußspannung	$I_F = 10\text{ mA}$		0,55	0,65	V
C_T Kapazität	$U_R = 0, f = 1\text{ MHz}$		0,75	1	pF

Betriebsdaten bei $T_U = 25\text{ °C}$

Parameter	Prüfbedingungen	min	typ	max	Einh.
F Rauschfaktor	$f = 900\text{ MHz}$ (s. Bild 1)		6,5	8	dB

Parameter-Meßbedingungen



Typische Kennlinien

